

Список основных публикаций ведущей организации
СПб Государственный Политехнический Университет

1. Влияние поперечного электрического поля и температуры на поглощение света в туннельно-связанных квантовых ямах GaAs/AlGaAs. Д.А.Фирсов, Л.Е.Воробьев, М.Я.Винниченко, Р.М.Балагула, М.М.Кулагина, А.П.Васильев, Физика и техника полупроводников 49, вып. 11, 1473-1477 (2015).
2. Mid-infrared light absorption by photo-excited charge carriers in Ge/Si quantum dots. L.E.Vorobjev, D.A.Firsov, V.Yu.Panevin, A.N.Sofronov, R.M.Balagula, A.A.Tonkikh, J. Phys.: Conf. Ser. 586 012001 (2015).
3. Терагерцовое излучение, связанное с примесными переходами электронов в квантовых ямах при оптической и электрической накачке. Д.А.Фирсов, Л.Е.Воробьев, В.Ю.Паневин, А.Н.Софронов, Р.М.Балагула, И.С.Махов, Д.В.Козлов, А.П.Васильев, Физика и техника полупроводников 49, вып. 1, 30-34 (2015).
4. Photoinduced absorption and photoconductivity of Ge/Si quantum dots in mid-infrared range under interband excitation. R.M.Balagula, A.N.Sofronov, V.Yu.Panevin, D.A.Firsov, L.E.Vorobjev, A.A.Tonkikh, P.Werner, J. Phys.: Conf. Ser. 541 012087 (2014).
5. Mid infrared optical properties of Ge/Si quantum dots with different doping level. A.N.Sofronov, D.A.Firsov, L.E.Vorobjev, V.A.Shalygin, V.Yu.Panevin, M.Ya.Vinnichenko, A.A.Tonkikh, S.N.Danilov, AIP Conference Proceedings 1566, 441 (2013).
6. Латеральная фотопроводимость структур с квантовыми точками Ge/Si. В.Ю.Паневин, А.Н.Софронов, Л.Е.Воробьев, Д.А.Фирсов, В.А.Шалыгин, М.Я.Винниченко, Р.М.Балагула, А.А.Тонких, P.Werner, V.Fuhrman, G.Schmidt, Физика и техника полупроводников 47, вып. 12, 1599-1603 (2013).
7. Динамика фотолюминесценции в наноструктурах с квантовыми ямами InGaAsSb/AlGaAsSb. М.Я.Винниченко, Д.А.Фирсов, Л.Е.Воробьев, М.О.Машко, L.Shterengas, G.Belenky, Физика и техника полупроводников 46, вып. 12, 1581-1586 (2012).
8. Фотоиндуцированное и равновесное поглощение света в квантовых точках Ge/Si. Л.Е.Воробьев, Д.А.Фирсов, В.А.Шалыгин, В.Ю.Паневин, А.Н.Софронов, А.И.Якимов, А.В.Двуреченский, А.А.Тонких, P.Werner, Физика и техника полупроводников 46, вып. 12, 1566-1570 (2012).
9. Intraband spectroscopy of excited quantum dot levels by measuring photoinduced currents. B.Eichenberg, S.Dobmann, H.Wunderlich, A.Seilmeier, L.E.Vorobjev, D.A.Firsov, V.Panevin, A.A.Tonkikh, Physica E 43, 1162–1165 (2011).

